(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
H01L 21/304

(11) 공개번호 특1996-0012348
(43) 공개일자 1996년04월20일

(21) 출원번호 특1995-0029743
(22) 출원일자 1995년09월13일
(30) 우선권주장 P4432738.2 1994년09월14일 독일(DE)
(71) 출원인 지멘스 악티엔게젤샤프트 알베르트 발도르프.롤프 옴케
독일연방공화국 80333 뮌헨 빗텔스바헬플랏츠 2
(72) 발명자 레히너, 알프레트
독일연방공화국 93138 라페르스도르프 고트프리트-헤르더-슈트라쎄 5
뮐러, 에리히
독일연방공화국 93161 진찡 암 호엔 랑켄 15
리거, 발터
독일연방공화국 93138 라페르스도르프 베르크슈트라쎄 53
(74) 대리인 남상선

심사청구 : 없음

(54) 반도체 결정표면 상의 오염을 제거하기 위한 방법

요약

세척매질로서 고순도 탈이온수가 사용되며 금속 착물 형성제, 예컨대 에틸렌디아민테트라아세테이트(EDTA)에 ppm의 농도 범위로 첨가된다. 고순도의 값비싼 화학약품 혼합물의 준비가 생략된다.

명세서

[발명의 명칭]

반도체 결정표면 상의 오염을 제거하기 위한 방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

반도체 결정표면 상의 오염을 제거하기 위한 방법에 있어서, 습윤된 화학적 세척매질로서 고순도 탈이온수가 사용되며, 금속 착물 형성제에 ppm의 농도 범위로 첨가되는 것을 특징으로 하는 반도체 결정표면 상의 오염을 제거하기 위한 방법.

청구항 2

제1항에 있어서, 세척이 부가의 초음파 작용하에 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 결정표면 상의 오염을 제거하기 위한 방법.

청구항 3

제1항 또는 제2항에 있어서, 부가의 표면장력감소 물질이 세척매질에 첨가되는 것을 특징으로 하는 반도체 결정표면 상의 오염을 제거하기 위한 방법.

청구항 4

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 세척이 부가의 오존공급하에 이루어지는 것을 특징으로 하는 반도체 결정표면 상의 오염을 제거하기 위한 방법.

청구항 5

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 금속 착물 형성제로서 에틸렌디아민테트라아세테이트(EDTA)가 사용되는 것을 특징으로 하는 반도체 결정표면 상의 오염을 제거하기 위한 방법.

청구항 6

제5항에 있어서, 금속 착물 형성제가 수용액중에서 약 0.7ppm의 농도로 사용되는 것을 특징으로 하는 반도체 결정표면 상의 오염을 제거하기 위한 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.